



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H 2222A

对应国外型号
MPS2222A

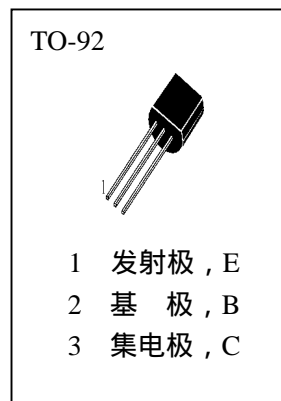
主要用途

作音频功率放大，激励级放大、开关应用

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极耗散功率.....	625mW
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	75V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	40V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	6V
I_C	——集电极电流.....	600mA

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	75			V	$I_C=10\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	40			V	$I_C=10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=10\mu A, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			10	nA	$V_{CB}=60V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			10	nA	$V_{EB}=3V, I_C=0$
H_{FE}	直流电流增益	100		400		$V_{CE}=10V, I_C=150mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.3	V	$I_C=150mA, I_B=15mA$
f_T	特征频率	300			MHZ	$V_{CE}=20V, I_C=20mA$
C_{ob}	共基极输出电容			8	pF	$V_{CB}=10V, I_E=0$ $f=1MHz$